PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-062491

(43)Date of publication of application: 28.02.2002

(51)Int.Cl.

G02B 26/02 H04N 5/225 H04N 5/238

HO4N 9/04 // HO4N 9/07

(21)Application number : 2000-246388

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

15.08.2000

(72)Inventor: SATO HIDEKI

(54) IMAGE PICKUP OPTICAL SYSTEM AND LIGHT QUANTITY CONTROLLER USING INTERFEROMETRIC MODULATION DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shutter device and a color separating device which use an interferometric modulation(IMOD) device.

SOLUTION: A light beam which is made incident on the IMOD device 7 through an optical system is separated at high speed into reflected light beams (red. green, and blue) of particular wavelengths by driving the reflector of the IMOD device 7. The IMOD device 7 may be formed of a single pixel or constituted into a panel composed of pixels. The light intensity from the IMOD device 7 is put into a storage device 13 such as a frame memory. Once one set of red, green, and blue beams is taken in, the three colers are mixed. The IMOD device 7 and

storage device 13 are synchronized with each other. By this method, the same effects as a three-plate system can be obtained although the constitution is of a single-plate type. This elements are more small-sized and lightweight than a cross dischroic prism which is used normally as the three-plate type.

SUZUYF & SUZUYF

Partial Translation of Reference 2

Jpn. Pat. Appln. KOKAI Publication No. 2002-62491

Filing No.: 2000-246388 Filing Date: August 15, 2000 Applicant: Cannon Inc. Priority: Not Claimed

KOKAI Date: February 28, 2002 Request for Examination: Not filed

Int.Cl.: G02B 26/02 H04N 5/225 5/238 9/04

Partial Translation A

(From page 3, column 3, line 32 to column 4, line 14)

[Embodiment of the Invention] An embodiment of the present invention will be now described with reference to the drawings. FIG. 1 illustrates a main structure of a portion proximity of one pixel structure of an interference modulation (IMOD) element in a first embodiment. The element actually has a number of the structures, Reference numeral 1 denotes a substrate glass. Incident light permeates through the substrate glass. Each of reference numerals 2-4 denotes a dielectric layer or a thin film of a metal layer. An optical resonance layer 5 is formed of these layers whose thicknesses are appropriately set. Reference numeral 6 is a reflector. Distance T between the optical resonance layer 5 and the reflector 6 is changed by a driving structure which is not shown in the drawing. By changing distance T, the characteristics of light absorption and light reflection are changed. Thereby, an image is displayed. [0013] Unlike incident light, reflected light is emitted out from the substrate glass 1. When distance T is controlled in such a way that light is absorbed, reflectivity is lowered and "black" is displayed as an image. When distance T is controlled in such a way that all of red, green and blue light are reflected, the three colors overlap and "white" is displayed. Since the reflector 6 is driven by electrostatic force, remarkably high-speed operation is possible.

[0014] If the feature of the interference modulation (IMOD) element, which takes

SUZUYE & SUZUYE

Partial Translation of Reference 2

Page 2/2

"black" as absorption of light (no reflection) and "white" as reflection of light, is combined with the feature enabling high-speed operation, the IMOD element can be used for a reflective-type optical amount controlling mechanism of an image pick-up optical system, such as a camera. This is explained in FIGS. 2 and 3. In FIGS. 2 and 3, reference numeral 7 denotes the interference modulation (IMOD) element. In FIG. 2, all light is reflected and "white" is displayed. In FIG. 3, all light is absorbed and "black" is displayed. To make the condition of the IMOD element easy to understand, the IMOD element 7 in FIG. 2 is white to show a reflective condition. The IMDO element in FIG. 3 is black to show a non-reflective condition. Reference numeral 8 shown in FIGS. 2 and 3 is an imaging screen, such as a film, a CCD, and a CMOS sensor.

対応なし、英抄

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号 特開2002-62491 (P2002-62491 A)

	/r = = = =				
(43)公開日	平成14年2	月28日 (2002.2.2)			

(51) Int.CL*		識別記号	FI			₹-₹3-}*(参考)		
GD2B	26/02			G 0 2	218 26/02		J	2H041
							E	5 C O 2 2
H04N	5/225			но-	N 5/225		D	5 C O 6 5
	5/238				5/238		Z	
	9/04				9/04		z	
			数を軽力	*#*	新を頂の取り	OI.	(全 6 百)	最終百に続く

(71)出願人 000001007 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 佐藤 英樹 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内 (74)代理人 100065385

弁理士 山下 模平 Fターム(参考) 23041 AA04 AA05 AA21 AB10 AC08

AZOS

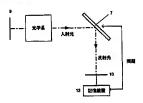
50022 AC51 AC62 AC55 50085 AA01 HB48 EE18

(54) 【発明の名称】 干渉性変調素子を用いた機像光学系及び光量制御装置

(57) [要約]

【課題】 干渉性変調 (IMOD) 素子を用いるシャッ ター素子及び色分解素子を提供する。

「解除を見」 ※字系を力して1MOD素子7に入射した光線は、1MOD素子7の反射器の駆動により、ある 物定の液長の反射光点、線、等)と高速で分離される り変しの素分では、1つの開業で形成されても見いし、 複数の回激からなるイルれたで構成されても見いし、 複数の回激からなるイルれたで構成されても見いし、 は、一般である。 13 に取り込まれる。 赤、線、中が1銀可り込まれた。 13 は同時とはている。この方法によれば、構成は伸収子、 3 は同時させている。この方法によれば、構成は伸収子、 でありたから、多数式と回線の発水等もわる。連常3 板式で用いられるクロスダイクロイックプリズムと比較 すると、小型等でする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 干渉を利用して光変質を行う干渉性変調 業子によって光量制御を行うことを特徴とする操像光学 系。

【請求項2】 誘電体階と金属層からなる複数の膜を逃 明基板上に積層した光共振層を有する光入射部と、可動 反射線とを、対峙させる干渉性変調素子を使用する提像 光学系であって、

前記撮像光学系において光量を制御する部分に、前記干 像光学系。

【糖求項3】 前記光入射部と、前記可助反射鏡とを、 空気層を介して対峙させることを特徴とする請求項2記 鉞の撮像光学系。

【請求項4】 誘電体層と金属層からなる複数の層を透 明基板上に種屋した光井振翔を有する光入射部と 可動 反射鏡とを対峙させる干渉性変調素子を使用する光量制 御装置であって、

前記電圧を制御して前記干渉性変調素子の光学特性の階 る光量制御装置。

【請求項5】 前記光入財部と、前記可動反射鏡とを、 空気層を介して対峙させることを特徴とする請求項4記 戦の光量制御装置。

【請求項6】 誘電体層と金属層からなる複数の層を通 脚基板 トに種屋した光共振器を有する光入射部と、可動 反射鏡鏡とを、空気層を介して対峙させる干渉性変調素 子を使用する光量制御装置であって、

前記干渉性変調素子を複数個数け、一部の数の前配干渉 性変調素子の光学特性を第1状態に制御し、残りの数の 30 前記干渉性変調素子の光学特性を第2状態に制御して光 量制御を行うことを特徴とする光量制御装置。

【請求項7】 色分解光学系において色分解を行う部分 に設けた前記干渉性変調素子と、前記干渉性変調素子か らの出力光磁度を記憶する記憶装置とを備え、

前記干渉性変類素子に凹加する電圧を制御して前記色分 解を行い、

前記色分解の結果を記憶装置に格納することを特徴とす る請求項1、2、3のいずれか一つに記載された撮像光 学系。

【請求項8】 前記干渉性変調業子は、前記光入射部か ち光を入射させ、前記可動反射鎖で前記光を反射させ、 前記光入射部から前記光を出射させる反射型の干渉性変 調素子であることを特徴とする請求項2、3、7のいず れか一つに記載された摄像光学系。

【請求項9】 前記干渉性変調素子は、前記光入射部か ち光を入射させ、前記可動反射線で前記光を反射させ、 前記光入射部から前記光を出射させる反射型の干渉性変 調素子であることを特徴とする請求項4.5、8のいず れかに紀載された光量制御装置。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明が属する技術分野】本発明は、干渉性変調(Inte rferometric Modulation: IMOD) 素子を用いた操像光 学系及び光量制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】光の干渉作用を利用して光の変調を行う 画像表示素子が、特表2000 - 500245号公報、特表平10-5 00224号公報、USP5835255、USP6055090、USP6040937等 渉性変調素子を設け、光量制御することを特徴とする操 10 に開示されている。これらは、MEM5(micro electric me chanical system)の技術とファブリ・ペロー干渉計など に見られる光の共振作用とを複合して光を変調するもの

> 【0003】図11は、干渉性変調 (IMDO) 素子の概要 を示したものであり、反射器100は、スペーサ102を介し て勝104、106、108を含む誘導吸収体105と対抗して配置 されており、入射媒体11.0は誘導吸収体105と片方の境界 で接している。

[0004]光は、入射媒体110より入射し、反射器100 調を変えることによって光量制御を行うことを特徴とす 20 により反射され、入射媒体110より射出する。反射器100 と誘導吸収体105の間隔Tが可変となっておりこの間隔を 変更することで光学特性を変化させることができる。胰 104、106、108はたとえば、二酸化ジルコニウム、タン グステン、二酸化シリコンである。間隔Tを変化させる ための構造としては、図12のようなMBISの構造が採用 されている。この構造により静電気により非常に高速に 光の変調を行うことができる。図13-図16までは、 スペーサとの間隔が異なる場合の光学特性の変化であ る。各図とも縦軸が反射率、横軸が波長である。

【0005】図13は、スペーサの間隔がある値の時に 示す光学特性であり、図に示したように反射率が可視光 域全般にわたって低い状態である。この場合、 "黒" を 表示している。

【0006】図14 - 図16は、それぞれ間隔Tがある 値のときの特性であり、それぞれ青、緑、赤を表示して いることになる。こうした構造を2次元的に配置し、輌 御することでカラーの画像を表示するととができる。反 射器100の駆動には、たとえば静電力が使われる。この ため、非常に高速の動作ができる。画像表示の階間性の 40 表現にあたっては、あるエリア内の反射率の高い状態の 画表の割合か変える面積階額、あるいは、高速で動作で きることを利用した時分割の階調表現を利用することが

できる。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】前述した干渉性変調 (TMDD) 素子は、ある光源により適切に照明して、その 画像をスクリーン上に形成することを想定している。と の干洗件変調 (IMDD)素子の持つ高速に階調を変えられ るという特徴は、撮像光学系等でのシャッターとして光 50 量を変化させる用途やダイクロイック膜などの代わりに

IMOD素子からの出射光の波長を制御すること等にも使用 できるとも考えられるが、そのような発明は、いまだ関 示されていない。

【0008】そこで、本発明は、TMOD素子を用いるシ+ ッター素子及び色分解素子を提供することを課題として

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた めの本発明の振像光学系は、干渉を利用して光変調を行 う干渉性変調素子によって光量制御を行う。具体的に は、この提像光学系は、誘電体層と金属層からなる複数 の膝を透明基板上に精層した光共振層を有する光入射部 と、可動反射鏡とを、対峙させる干渉性変調素子を使用 する振像光学系であって、前記撮像光学系において光量 を制御する部分に、前紀干渉性変調素子を設け、光量制 御する。

【0010】又、本発明の光量制御装置は、誘電体障と 金属層からなる複数の関を透明基板上に積層した光井振 層を有する光入射部と、可助反射線とを対峙させる干渉 性変調素子を使用する光量制御装置であって、前記電圧 20 を制御して前配干渉性変調業子の光学特性の階間を変え るととによって光量期御を行う。

【0011】又、本発明の光量制御装置は、誘電体層と 金属層からなる複数の層を透明基板上に積層した光共振 層を有する光入射部と、可動反射鏡とを、空気層を介し て対峙させる干渉性変調素子を使用する光量制御装置で あって、前記干渉性変調素子を複数個設け、一部の数の 前記干渉性変調素子の光学特性を第1状態に制御し、残 りの数の前配干渉性変調素子の光学特性を第2状態に制 御して光量制御を行う。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 筋の形態について説明する。図1に、第1の実施形態に おける干渉性変調 (IMOD)素子の1つの画素構造近傍の 主要構造を示す。実際の素子は、との構造を多数有して いる。1 は基板ガラスをあらわしており、入射光はこの 基板ガラスを透過する。2、3、4はそれぞれ、誘電体 層あるいは会議層の薄膜を示しており、これらの原みを 適切に選ぶことにより光の共振層5を形成している。6 は反射器で、図示していない駆動構造により、共振層 5 と反射器6の間隔Tが変化する。このTを変化させるこ とにより、光の吸収と反射の特性が変化することとな り、画像を表示することが可能である。

[0013] 反射光は、入射光と逆にガラス基板1より 射出していく。間隔Tを制御し光を吸収させると、反射 率が低くなり面像としては "異" を表示するようにな る。また、逆に間隔Tを制御し、赤、緑、青の光を全て 反射するようにすると、3色が重なり、画像は "白" を 表示する。この反射器6は例えば静電力により駆動され るため、非常に高速に動作を行うことができる。

【0014】干渉性変調(DADD)素子において"黒"は 光線を吸収(無反射)、"白"は光線を反射するものと 捉え、かつ高速動作できる特徴を組み合わせれば、例え ばカメラなどの損像光学系等における反射型の光量制御 機構として使用することが出来る。このことを図2、図 3で説明する。図2、図3において、7は干渉性変調 (11400)素子を表している。図2は全ての光を反射し

て、"白"を表示している場合、図3は全ての光を吸収 して"黒"を表示している場合を示している。IMDO素子 の状態を分かりやすくするため、図2ではIMO案子7を 白く描いて反射状態を表し、図3ではIMO家子を黒く描 いて無反射状態を表している。図2、図3に示した8 は、結像面であり、フィルムやCCD、CMOSセンサー等を 表している。

【0015】図2で示すような"白"を表示しているIM co素子に入射した光は、そのまま反射し結像面に建す る。逆に図3に示すような"黒"を表示しているIMOO素 子に入射した光は、DAD素子に吸収され結像面に光は到 達しない。とのように、"白"、"黑"の表示を高速に 切り替えることにより、結像面に到達する光を制御する ととができるので、反射型の光量制御機構として使用す ることができる。

【0016】以上は、DMOD紫子は、入射光に対して45° に配置しカメラ等掛像光学系における反射制御機構とし て使用する例を示したが、これに限定されるものではな く、様々な角度から斜入射した光に対しても使用されて も良い。例えば、不図示であるが、光スイッチのような もので、DAD洗子の"白"、"黑"対してそれぞれをオ ン、オフする機構を備えるものである。また、例として IMDD素子を回転させる機構を備えれば、様々な方向から の光線を任意の方向に反射させることも出来る。また、 DMOXX子7は、1つの画業で形成されても良いし、複数 の画素からなるパネル状で構成されても良い。

【0017】本発明でのDMDC素子の使用法に際しては、 IMDD素子は干渉型の為、光線の入射角度によって光線の 波長が変化する。そのため、IMCO素子に対して垂直入射 した光線の液長と斜入射した光線の波長は異なるため、 赤、緑、青の光を合成した際には、"白"の出方が微妙 に異なり、反射率が変化することが考えられる。 このよ うな問題を退けるためには、斜入射した光線に対して、 所知の波長が得られるように誘電体層あるいは金属層の 膜を設計する、YMDD素子に入射する角度を一定とするよ うな光学系を配置する等の方法がある。 【0018】また、とれまでは"黒"、"白"について

鋭明を行ってきたが、これに限定するものではなく、IM cp素子に階調性を持たせることで、反射してくる光線の 量を階調の分だけ段階的に変化させることも出来る。 【0018】加えて、複数の画素からなるパネル状のIM 00素子においては、図5に示すように、各DMO0素子に印

50 加する電圧を制御して、反射光の強度分布を制御すると

とにより、撮像光学系における絞りとして使用すること ができる。この強度分布の形状に限定は無く、円形、多 角形等、様々な形状が可能である。又、階調性を持たせ た場合との組み合わせにより、階間性と絞りの効果を開 時に得られる。

【0020】次に、図4に透過型のTMOO案子を用いた際 の構成図を示す。図に示すように、反射器を共振層で挟 み光路を2倍にすることにより、IMOD素子は透過型のIM 00素子としても使用することが出来る。このような透過 型のIMCC素子を用いても同様の効果が得られる。

【0021】次に、本発明の第2の実施形態について脳 明する。

【0022】図6はIMDD素子7を色分解するための装置 として使った際の構成を示したものである。IMDD素子7 は第1の実施形態で示したものと同様の構成であるので 詳細な説明は省略する。 【0023】光学系を介してDADO素子7に入射した光線

は、DADD素子7の反射器の駆動により、ある特定の波長 の反射光(赤、緑、青)に分離される。また、1900素子の 駆動は非常に高速で行われるため、人間の眼に知覚され 20 ない速度であれば、色の発生に時間的な差が生じても、 人間は色が時分割されていることを知覚することは出来 ず、同時に分離されているように感じる。との特徴は、 DKCC素子をダイクロイック糖、クロスダイクロイックブ リズム等色分解素子の代りとして使うことが出来ること を示している。また、DAOC素子7は、1つの面素で形成

されても見いし、複数の国素からなるパネル状で構成さ

れても扱い。

【0024】IMDD素子7によって時間的に色分解された 光線は、時分割の3色操像光学系を介して、時間的な差 30 【図5】IMOO素子の干渉領域の変化 を持ってフレームメモリ等の記憶装置13に赤、緑、青 の順に取り込まれる。次に赤、緑、青が1組取り込まれ た段階で3色の色合成を行う。 ここでは赤、緑、青の順 序で取り込まれるとしたが、これに限定するものではな くどの順序でもよい。ととでは、DACD素子7と記憶装置 13は独立に動作している。

【0025】図7においては、IMD案子7と記憶装置1 3とを同期させて色分解と光の取り込みを行っている。 との方法によれば、構成は単板式でありながら、3板式 と同様の効果が得られる。また、通常3板式で用いられ 40 るクロスダイクロイックプリズムと比較すると、小型で 軽量の構成を達成できる。

[0026]図8は、図6に示した反射型色分解光学系 を、透過型のIMOD素子7を用いて、等価型色分解光学系 としたものである。

【0027】図9に従来のクロスダイクロイックプリズ ムを用いた場合、図10に同様の効果を得るためにIMCO 素子を用いた場合の構成図を示す。

【0028】本発明での反射表示装置の使用法に禁して

は、反射表示装置が干渉型の為、光線の入射角度によっ 50 6 反射器

て光線の波長が変化する。そのため、干渉型表示装置に 対して垂直入射した光線の波長と斜入射した光線の波長 は異なるため、赤、緑、青の光を合成した際には、

"白" の出方が微妙に裂なり、反射率が変化することが 考えられる。とのような問題を運けるためには、斜入射 した光線に対して、所望の波長が得られるように緊電体 層あるいは金属層の膜を設計する、DMCD素子に入射する 角度を一定とするような光学系を配置する等の方法があ

10 【0029】また、複数の画素からなるパネル状のDMOO 素子においては、図5に示すような干渉の起きる領域を 変化させ、出射光の径(または断面形状)を変化させるこ とにより、撮像光学系における絞りとしての効果も期待 でき、色分解と絞りの効果を間時に得られる。ここで述 べた干渉の起こる領域は、形状に限定は無く、円形、多 角形等、様々な形状が可能である。

[0030]

[発明の効果]以上説明した本発明によれば、DADO素子 を光量制御機構、波長制御機構として撮像光学系の適切 な位置に配置することで、小型で軽量な光学系を実現す るととが出来る。

【関面の簡単な説明】

【関1】IMCO案子の斜视図

【図2】IMO素子の表示が白の場合における第1実施形 態の構成図

【図3】TMの本子の表示が黒の場合における第1実施形 態の構成図

【図4】 透過型のDMDD素子を用いた際の第1実施形態の 推成図

【図6】本発明にかかる第2実施形態の構成図

【図7】 IMO0素子と色信号の記憶装置を問期させた第2 実施形態の構成図

【図8】透過型のDMO2素子を用いた際の第2実施形態の 构成図

【図9】 従来のダイクロイックプリズムによる色分解 【図10】本発明におけるTMDO素子による色分解

【図11】TMOD素子の構成図

【図12】BADD素子の反射器の構成図

【図13】IMOD索子の特性(風) 【図14】1MOD素子の特性(青)

【図15】IMOO素子の特性(縁)

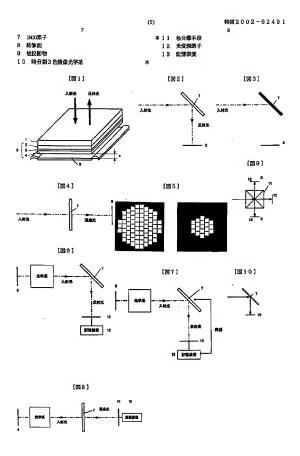
【図16】 IMOO素子の特性(赤)

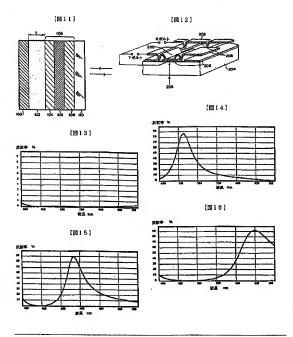
【符号の説明】 1 基板ガラス

2 薄膜 3 遊聴

4 难障

光共振部





フロントページの続き

(51)Int.Cl.' // H04N 9/07 識別記号

F I H O 4 N 9/07 テーマコート"(登考)